

Памяти И.Н. Яссиевич



30 июля этого года от нас ушла Ирина Николаевна Яссиевич, доктор физико-математических наук, профессор, выдающийся физик-теоретик и педагог, воспитавший не одно поколение ученых, внесшая заметный вклад в создание российской школы теории полупроводников. Еще учась в средней школе, Ирина Николаевна решила посвятить себя физике. В 1959 году она окончила физический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) и начала работать в Ленинградском Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе (ФТИ) под руководством Л.Э. Гуревича. От своего отца, Николая Никодимовича Яссиевича, известного художника-реалиста 30–40-ых годов прошлого века, она унаследовала яркое образное мышление. Она не только теоретически анализировала и объясняла наблюдаемые экспериментаторами новые физические явления в полупроводниковых материалах, но и сама предлагала постановку опытов для проверки выводов теории, часто помогая доводить научные результаты до практического применения. Она была настоящим генератором идей, которыми охотно делилась с коллегами.

Важным достижением Ирины Николаевны (совместно с А.П. Дмитриевым) является работа по расчету функции распределения горячих носителей в сильных электрических полях, приведшая к пониманию физики явлений ударной ионизации в полупроводниках $A^{III}B^V$.

Эти работы заложили основы для создания быстродействующих лавинных фотодиодов, перспективных для применения в волоконно-оптических линиях связи и информационных технологиях. Безусловно нужно упомянуть ее значительный вклад в развитие теории безызлучательной рекомбинации (совместно с В.И. Перелем и В.Н. Абакумовым), теории глубоких центров в полупроводниках (совместно с В.И. Перелем), теории аномального эффекта Холла (совместно с В.Н. Абакумовым), разработку теоретических моделей для описания оптических свойств кремниевых наноструктур (совместно с О.Б. Гусевым, М.С. Бреслером и Томом Грегоркевичем). Ее последняя важная работа в 2017 году была посвящена моделированию электронных и структурных свойств нанокристаллов в приближении сильной связи. Особенно следует отметить монографию „Безызлучательная рекомбинация в полупроводниках“ (совместно с В.И. Перелем и В.Н. Абакумовым), изданную за рубежом в 1991 году, а затем в России в 1997 году. Эта книга стала классическим учебником в этой области для поколений физиков-теоретиков.

Ирина Николаевна имела высокий международный авторитет. В начале перестройки, как только появилась возможность, Ирина Николаевна стала активно сотрудничать с зарубежными коллегами. В начале девяностых годов она работала в американских университетах Массачусетса и Аризоны. Долгое время работала приглашенным профессором в Лундском университете в Швеции. Регулярно посещала с научными визитами университеты Регенсбурга и Франкфурта-на-Одере в ФРГ. На протяжении 28 лет плодотворно сотрудничала с Университетом Амстердама, приезжая туда ежегодно со своими коллегами и аспирантами из ФТИ.

Много внимания и заботы И.Н. Яссиевич уделяла подготовке молодых научных кадров не только в России, но и за рубежом. Под ее руководством защищено свыше 15 кандидатских диссертаций. Среди ее учеников более 10 докторов наук. Защита ее последнего аспиранта была запланирована на осень этого года. Ее путь в науке не всегда был легким, но она умела бороться и побеждать. Ирина Николаевна прожила трудную, но счастливую жизнь, вырастила и воспитала трех дочерей, всегда оставаясь главой большой семьи. Она была открытым и приветливым человеком, любила жизнь во всех ее проявлениях. Хорошо знала классическую литературу, поэзию, любила природу, живопись, музыку.

Ирина Николаевна является для нас примером многолетнего беззаветного творческого служения науке. Светлая память о ней навсегда останется в умах и сердцах ее учеников, коллег и друзей.

*Коллеги, ученики, друзья и редколлегия журнала
„Физика и техника полупроводников“*